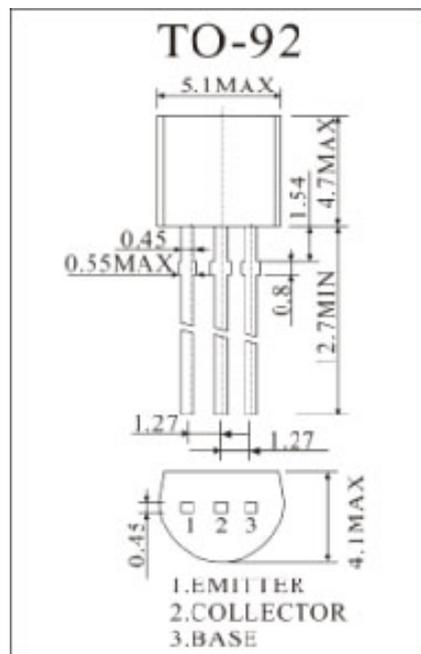


■ ■ 主要用途：高频、甚高频放大及振荡等。

■ ■ 绝对最大额定值 (Ta=25℃)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CB0}	35	V
集电极—发射极电压	V _{CEO}	30	V
发射极—基极电压	V _{EBO}	4	V
集电极电流	I _C	50	mA
集电极耗散功率	P _C	625	mW
结 温	T _J	150	℃
存储温度	T _{stg}	- 55~150	℃



■ ■ 电参数 (Ta=25℃)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	40		240		V _{CE} = 12 V, I _C = 2 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			0.1	μ A	V _{CB} = 35 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EBO}			1	μ A	V _{EB} = 4 V, I _C =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	35			V	I _C = 0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	30			V	I _C = 1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	4			V	I _E = 0.1 mA, I _C =0
基极-发射极电压	V _{BE}		0.7	1	V	V _{CE} = 10 V, I _C = 1 mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}			0.4	V	I _C = 10 mA, I _B = 1 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}			1	V	I _C = 10 mA, I _B = 1 mA
电流增益-带宽乘积	f _T	100	300		MHz	I _C = 1 mA, V _{CE} = 10 V
共基极输出电容	C _{ob}		2	3.2	PF	V _{CB} =10 V, I _E =0, f= 1 MHz
功率增益	G _P	27	29	33	dB	V _{CE} = 6 V, I _E = -1 mA f=0.7 MHz

■ ■ h_{FE} 分档及其标识志

分 档	R	O	Y
h _{FE}	40~80	70~140	120~240